

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



URKUNDE

über die Erteilung des
Patents

Nr. 43 32 653

Bezeichnung:

Monolithisch integriertes Halbleiterelement, dessen
Verwendung sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen
Halbleiterelementes

Patentinhaber:

Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V.,
78052 Villingen-Schwenningen, DE

Erfinder:

Alavi, Mani, Dipl.-Ing. Dr., 78050 Villingen-Schwenningen,
DE; Fabula, Thomas, Dipl.-Phys., 78073 Bad Dürkheim, DE;
Schumacher, Axel, Dipl.-Phys., 78083 Dachingen, DE;
Wagner, Hans-Joachim, Dipl.-Phys., 79098 Freiburg, DE

Tag der Anmeldung: 24.09.1993

München, den 01.09.1994

Der Präsident
des Deutschen Patentamts



Prof. Dr. Häußer